SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

Patent number:

JP2001339639

Publication date:

2001-12-07

Inventor:

SETODA MASAZUMI

Applicant:

VICTOR CO OF JAPAN LTD

Classification:

- international:

H04N5/335; H01L27/146; H01L31/10

Application number:

JP20000154023 20000525

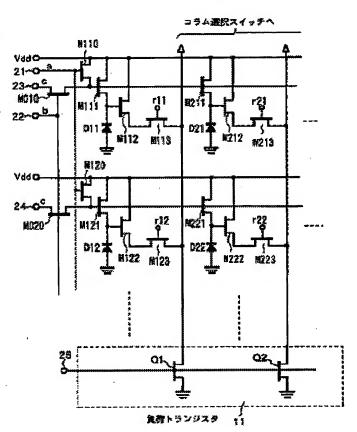
Priority number(s):

Report a data error here

Abstract of JP2001339639

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solid-state image pickup device that can select the most suitable pixel configuration in accordance with the intended use, while in the prior art different pixel configurations must be selected in accordance with the intended use since a dynamic range is too small for APS with a linear amplifier, and contrast is so bad for APS with a log amplifier as to have a problem with image quality.

SOLUTION: A transistor M110 (M120) that is controlled for switching on or off applying of power source and voltage Vdd at the same time to gates of transistors M111 and M211 (M121 and M222) disposed on the same line out of transistors M111 to M221 for resetting so that the transistors M111 and M211 (M121 and M222) may operate in a sub-threshold area, and a transistor M010 (M020) that is controlled for switching on or off applying of a reset pulse at the same time to the gates of transistors M111 and M211 (M121 and M222) are provided. These transistors are controlled selectively so that one transistor may be turned on and the other may be turned off.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-339639

(P2001-339639A)

(43)公開日 平成13年12月7日(2001.12.7)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ		รั	7]}*(参考)	
H04N	5/335			H04N	5/335	E	4M118	
H01L	27/146		-	H01L	27/14	Α	5 C 0 2 4	
	31/10				31/10	G	5 F O 4 9	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21) 出願番号	特願2000-154023(P2000-154023)	(71)出顧人	000004329		
			日本ピクター株式会社		
(22)出願日	平成12年5月25日(2000.5.25)		神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番		
			地		
		(72)発明者	瀬戸田 正純		
			神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番		
			地 日本ピクター株式会社内		
		(74)代理人	100085235		
			弁理士 松浦 兼行		

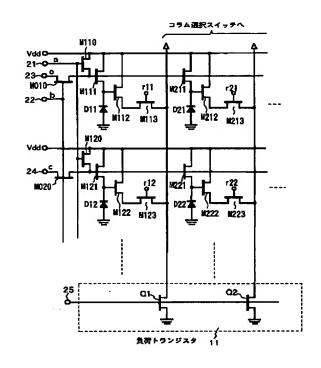
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 固体撮像装置

(57)【要約】

【課題】 リニアアンプを用いたAPSでは、ダイナミックレンジが足りず、ログアンプを用いたAPSでは、コントラストが悪く、画質に問題があるため、従来では、使用目的に応じて画素部を別々の構成としなければならない。

【解決手段】 リセット用トランジスタM111~M221のうち、同じ行に配列されたトランジスタM111 とM211 (M121とM222) のゲートに、このトランジスタをサブスレッショルド領域で動作する電源電位Vddを同時に印加するオン状態か、あるいはオフ状態にスイッチング制御される、トランジスタM110 (M120)と、トランジスタM111とM211 (M121とM222) のゲートに、リセットバルスを同時に印加するオン状態か、あるいはオフ状態にスイッチング制御される、トランジスタM010 (M020) を設ける。これらのトランジスタは、一方をオン状態、他方をオフ状態に選択制御される。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 二次元マトリクス状に配列された複数の画素をそれぞれ構成する複数のフォトダイオードのカソード電位を、対応するソースフォロワ回路を通して映像信号として出力する画素部を備えた固体撮像装置において、前記複数のフォトダイオードの各カソード側に設けられた、リセットパルスによりスイッチングする複数のリセット用トランジスタと、

前記複数のリセット用トランジスタのうち、同じ行に配列された複数のリセット用トランジスタのゲートに、とのリセット用トランジスタをオン状態となる以前のサブスレッショルド領域で動作させるべく電源電圧を同時に印加するオン状態か、あるいはこの電源電圧の印加を禁止するオフ状態にスイッチング制御される、各行毎に設けられた第1のスイッチング用トランジスタと、

前記複数のリセット用トランジスタのうち、同じ行に配列された複数のリセット用トランジスタのゲートに、前記リセットパルスを同時に印加するオン状態か、前記リセットパルスの通過を阻止するオフ状態にスイッチング制御される、各行毎に設けられた第2のスイッチング用20トランジスタとを有し、手動又は自動により前記第1及び第2のスイッチング用トランジスタの一方をオン状態、他方をオフ状態に選択制御することを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】 前記映像信号の1フィールド又は1フレーム内の最大輝度と最小輝度の差を求め、その差が予め設定した参照電圧以上かどうかに応じて異なる論理値の信号を出力する電圧比較回路と、前記電圧比較回路の出力信号の論理値に応じて前記第1及び第2のスイッチング用トランジスタの一方をオン状態、他方をオフ状態に選択制御するスイッチング信号を出力する切替回路とを有するととを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項3】 前記切替回路は、前記差が前記参照電圧以上である撮像場面のダイナミックレンジが大きいときの第1の論理値の前記電圧比較回路の出力信号が入力されたときには、前記第1のスイッチング用トランジスタをオフとするスイッチング信号を出力して前記画素部をログアンプによる動作をさせ、前記差が前記参照電圧未満である撮像場面のダイナミックレンジが小さいときの第2の40論理値の前記電圧比較回路の出力信号が入力されたときには、前記第1のスイッチング用トランジスタをオフ、前記第2のスイッチング用トランジスタをオンとするスイッチング信号を出力すると共に、前記リセットパルスを出力して前記画素部をリニアアンプによる動作をさせることを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は固体撮像装置に係り、特にCMOSイメージセンサと称する固体撮像装置 50

に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の固体撮像装置(CMOSイメージセンサ)は、規則的に配列された多数の画素のフォトダイオードで光電変換されて得られた信号を、画素部で検出・増幅して撮像信号として出力する。従来の固体撮像装置の画素部の各画素は、図3(a)に示す等価回路のリニアアンプを用いたアクティブピクセルセンサ(APS)か、同図(b)に示す等価回路のログアンプを用いたAPSにより構成されている。

【0003】とこで、図3(a)に示すリニアアンプを用いたAPSでは、電界効果トランジスタ(FET)M1とM2の各ドレインが電源電圧Vddに接続され、トランジスタM1のソースとトランジスタM2のゲートが、画素を構成するフォトダイオードD1のカソードに接続されている。更に、トランジスタM2のソースが、トランジスタM3のドレイン、ソースを通して出力側に接続されている。

【0004】 このリニアアンプを用いたAPSの動作について説明するに、まず、トランジスタM1のゲートに端子1を介してリセットパルスが印加され、トランジスタM1がオンになり、トランジスタM1のドレイン、ソースを介してフォトダイオードD1のカソードの電圧が電源電位Vddにされる(リセットされる)。なお、このとき、トランジスタM3はオフである。続いて、トランジスタM1のゲートへのリセットパルスが消失してトランジスタM1がオフとなり、これにより、フォトダイオードD1のカソード電位がVddに維持される。

【0005】この状態で、フォトダイオードD1に光が 照射され、フォトダイオードD1が入射光を光電変換し て、照射光量(強度×時間)に比例した電荷Qがフォト ダイオードD1に蓄積され、フォトダイオードD1のカ ソードの電位がQ/Cなる電圧変化を起こす(ただし、 CはフォトダイオードD1の容量である。)。

【0006】その後、水平ライン読み出しのためのスイッチングパルスが端子2を介してトランジスタM3のゲートに印加されることにより、フォトダイオードD1の上記のカソード電圧変化分が、トランジスタM2と負荷トランジスタ(図示せず)からなるソースフォロワ回路及びトランジスタM3を通して映像信号として出力される。

【0007】次に、図3(b)に示すログアンプを用いたAPSでは、電界効果トランジスタ(FET)M4とM5の各ドレインとM4のゲートが電源電圧Vddに接続され、トランジスタM4のソースとトランジスタM5のゲートが、画案を構成するフォトダイオードD1のカソードに接続されている。更に、トランジスタM5のソースが、トランジスタM3のドレイン、ソースを通して出力側に接続されている。

【0008】このログアンプを用いたAPSの動作につ

いて説明するに、トランジスタM4のゲートには一定の 電源電圧Vddがバイアス電圧として印加されており、 トランジスタM4はオン状態となる以前のサブスレッシ ョルド領域で動作する。このサブスレッショルド領域で は、ドレイン電流はゲート・ソース間の電圧に対して、指 数関数的に増大する(対数曲線を示す)。

【0009】従って、この状態でフォトダイオードD1 に光が照射されると、フォトダイオードD1 で光電変換 された電流が流れ、この時のM4のソース電圧-D1の光 電流(ドレイン電流)の関係は、対数曲線を示し、非常に 10 広いダイナミックレンジが得られる。この時のフォトダ イオードD1のカソード電圧は、水平ライン読み出しの ためのスイッチングパルスが端子2を介してトランジス タM3のゲートに印加されてM3がオンされることによ り、トランジスタM5と負荷トランジスタ(図示せず) からなるソースフォロワ回路及びトランジスタM3を通 して映像信号として出力される。このログアンブを用い たAPSでは、120dBのダイナミックレンジのもの が報告されている(佐々木正明他、「対数圧縮СМОS イメージセンサとその応用」、IPU99-63)。

【発明が解決しようとする課題】しかるに、上記のリニ アアンプを用いたAPSによる画素部を有する従来の固 体撮像装置では、画質は良いが、ダイナミックレンジが 足りないという問題がある。一方、上記のログアンプを用 いたAPSによる画素部を有する従来の固体撮像装置で は、広いダイナミックレンジが得られる反面、コントラ ストが悪く、画質に問題がある。このため、従来の固体撮 像装置では、使用目的に応じて、画質を優先するときに は、画素部をリニアアンプを用いたAPSとし、ダイナ ミックレンジを優先するときには、画素部をログアンプ を用いたAPSとする別々の構成としなければならな

【0011】本発明は以上の点に鑑みなされたもので、 使用目的に応じて最適な画素構成を選択し得る固体撮像 装置を提供することを目的とする。

【0012】また、本発明の他の目的は、省電力化を図 り得る固体撮像装置を提供することにある。

[0013]

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達 40 成するため、二次元マトリクス状に配列された複数の画 素をそれぞれ構成する複数のフォトダイオードのカソー ド電位を、対応するソースフォロワ回路を通して映像信 号として出力する画素部を備えた固体撮像装置におい て、複数のフォトダイオードの各カソード側に設けられ た、リセットパルスによりスイッチングする複数のリセ ット用トランジスタと、複数のリセット用トランジスタ のうち、同じ行に配列された複数のリセット用トランジ スタのゲートに、このリセット用トランジスタをオン状 態となる以前のサブスレッショルド領域で動作させるべ 50 れか一方に選択される構成とされ、更にロー(Row)

く電源電圧を同時に印加するオン状態か、あるいはとの 電源電圧の印加を禁止するオフ状態にスイッチング制御 される、各行毎に設けられた第1のスイッチング用トラ ンジスタと、複数のリセット用トランジスタのうち、同 じ行に配列された複数のリセット用トランジスタのゲー トに、リセットパルスを同時に印加するオン状態か、リ セットパルスの通過を阻止するオフ状態にスイッチング 制御される、各行毎に設けられた第2のスイッチング用 トランジスタとを有し、手動又は自動により第1及び第 2のスイッチング用トランジスタの一方をオン状態、他 方をオフ状態に選択制御する構成としたものである。 【0014】との発明では、第1のスイッチング用トラ ンジスタをオフ状態、第2のスイッチング用トランジス タをオン状態としたときには、複数のリセット用トラン ジスタのゲートにリセットパルスが第2のスイッチング 用トランジスタを通して同時に印加されるようにできる ため、このときにはリニアアンプを用いた画素動作をさ せることができる。また、第1のスイッチング用トラン ジスタをオン状態、第2のスイッチング用トランジスタ をオフ状態に制御したときには、同じ行の複数のリセッ ト用トランジスタのゲートには、第1のスイッチング用 トランジスタを通して電源電圧がそれぞれ印加されて、 オン状態となる以前のサブスレッショルド領域でリセッ ト用トランジスタを動作させるため、ログアンプを用い た画素動作をさせることができる。また、このときリセ

【0015】また、本発明は上記の目的を達成するため、 映像信号の1フィールド又は1フレーム内の最大輝度と 最小輝度の差を求め、その差が予め設定した参照電圧以 上かどうかに応じて異なる論理値の信号を出力する電圧 比較回路と、電圧比較回路の出力信号の論理値に応じて 上記の第1及び第2のスイッチング用トランジスタの一 方をオン状態、他方をオフ状態に選択制御するスイッチ ング信号を出力する切替回路とを有する構成としたもの

ットパルスを不要にできる。

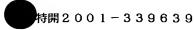
【0016】との発明では、撮像する画面内のダイナミ ックレンジに応じて、第1のスイッチング用トランジス タをオン状態、かつ、第2のスイッチング用トランジス タをオフ状態に自動的に制御するか、又は第1のスイッ チング用トランジスタをオフ状態、かつ、第2のスイッ チング用トランジスタをオン状態に自動的に制御すると とができる。

[0017]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい て図面と共に説明する。図1は本発明なる固体撮像装置 の一実施の形態のブロック図を示す。同図において、画 素部10は多数の画素が二次元マトリクス状に配列され ており、各画素は後述の図2に示すように、リニアアン プを用いたAPSと、ログアンプを用いたAPSのいず

(4)

40



選択スイッチ、リセットスイッチ、方式選択スイッチな ども含まれている。

【0018】また、画素部10は負荷トランジスタ11 に接続される一方、垂直シフトレジスタ (VSR) 12 からの垂直バルスがロー選択スイッチに供給され、水平 シフトレジスタ (HSR) 13からの水平パルスがコラ ム (Column) 選択スイッチ14を介して供給され、更に 負荷11にも供給される。更に、この実施の形態は、コラ ム選択スイッチ14の出力映像信号と端子16からの参 照電圧とを比較する電圧比較回路15と、電圧比較回路 10 15の出力電圧に応じて、画素部10へ出力するスイッ チングパルスa、方式選択パルスb及びリセットパルス cの論理値を変化させる切替回路17とを有している。 【0019】図2は画素部10及び負荷トランジスタ1 1の各一部の一実施の形態の回路図を示す。図2には画 素部10の4画素分の画素回路を示している。すなわ ち、フォトダイオードD11、D12、D21及びD2 2と、これらフォトダイオードD11、D12、D21 及びD22のカソードにソースが接続されているトラン ジスタ (FET) M111、M121、M211及びM 20 221と、これらフォトダイオードD11、D12、D 21及びD22のカソードにゲートが接続されているト ランジスタ (FET) M112、M122、M212及 びM222とが、上記の4つの画素を構成している。 【0020】また、トランジスタ (FET) M113、 M123、M213及びM223は、上記の4つの画素 に対応したロー選択スイッチで、それらのゲートには端 子rll、rl2、r21、r22には、図1の垂直シ フトレジスタ12からの垂直パルスが印加される。ま た、垂直方向に配列されたトランジスタM113、M1 23等のソースは負荷トランジスタQ1のドレインに接 続され、垂直方向に配列されたトランジスタM213、 M223等のソースは負荷トランジスタQ2のドレイン に接続されている。ソースが接地されているこれらの負 荷トランジスタQ1、Q2は、ゲートが端子25に共通 接続されており、この端子25には一定のバイアス電圧 が常時印加され、定電流源として動作するようにされて いる。

【0021】 このような画素回路に加えて、本実施の形 態では、第1行に配列されているトランジスタM11 1、M211等の各ゲートが、スイッチング用トランジ スタ (FET) M110のソースとトランジスタ (FE T) とM010のソースにそれぞれ接続されている。同 様に、第2行に配列されているトランジスタM121、 M221等の各ゲートが、スイッチング用トランジスタ (FET) M120のソースとトランジスタ(FET) MO20のソースにそれぞれ接続されている。更に、ト ランジスタM110、M120の各ゲートは端子21に 共通接続されており、トランジスタM010、M020 の各ゲートは端子22に共通接続されている。

【0022】次に、との実施の形態の動作について説明 する。いま、撮影場面が暗く、画質を優先したいときに は、切替回路17からローレベルのスイッチングパルス aと、ハイレベルのスイッチングパルスbが出力される と共に、リセットバルスcが順次に出力される。上記の ローレベルのスイッチングパルス a は、図2の端子21 を介してトランジスタM110、M120等のゲートに 印加されて、これらのトランジスタM110、M120-をオフとする。また、これと同時に、上記のハイレベルの スイッチングパルス bは、図2の端子22を介してトラ ンジスタM010、M020等のゲートに印加されて、 これらのトランジスタMO10、MO20等をオンとす

【0023】この状態で、切替回路17からのハイレベ ルのリセットパルスcが端子23、24等から、オン状態 にあるトランジスタM010、M020等を介して同じ 水平ライン (行) にあるトランジスタM111、M21 2等、M121、M222等をそれぞれオンとして、そ **れらのトランジスタM111、M212、M121、M** 222等のドレイン、ソースを介してフォトダイオード D11、D21、D12、D22等のカソードの電圧が 電源電位Vddにされる(リセットされる)。なお、こ のとき、トランジスタM131、M213、M123、 M223はオフである。続いて、上記のリセットバルス cが消失してトランジスタM1がオフとなり、これによ り、フォトダイオードD1のカソード電位がVddに維 持される。

【0024】との状態で、フォトダイオードD11、D 21、D12、D22等に光が照射され、フォトダイオ 30 ードD11、D21、D12、D22等が入射光を光電 変換して、照射光量(強度×時間)に比例した電荷Qが フォトダイオードD11、D21、D12、D22等に 蓄積され、フォトダイオードD11、D21、D12、 D22等のカソードの電位がQ/Cなる電圧変化を起と

【0025】その後、図1の垂直シフトレジスタ12か らのハイレベルの垂直パルスが、ある1水平走査期間 (1H)は、端子r11、r21等を介して1行目の同 じ水平方向に配列されたトランジスタM113、M21 3等のゲートに印加されて、これらのトランジスタをオ ンとするため、この1H期間では、1行目の水平方向に 配列されているフォトダイオードD11、D21の上記 のカソード電圧変化分が、トランジスタM113、M2 13等と負荷トランジスタQ1、Q2等からなるソース フォロワ回路を通して、図1のコラム選択スイッチ14 へ映像信号として出力される。コラム選択スイッチ14 からは同じ水平ライン上の多数のフォトダイオードから の電圧変化分が、1 H内の映像期間内で順次切替出力さ れる。

【0026】次の1 H期間では、垂直シフトレジスタ1

特開2001-339639

2からのハイレベルの垂直パルスが、端子 r 12、 r 2 2等を介して2行目の水平方向に配列されたトランジス タM123、M223等のゲートに印加されて、とれら のトランジスタをオンとするため、この1 H期間では、 2行目の水平方向に配列されているフォトダイオードD 12、D22の上記のカソード電圧変化分が、トランジ スタM123、M223等と負荷トランジスタQ1、Q 2等からなるソースフォロワ回路を通して、図1のコラ ム選択スイッチ14へ映像信号として出力される。コラ ム選択スイッチ14からは2行目の水平ライン上の多数 10 のフォトダイオードからの電圧変化分が、1 H内の映像 期間内で順次切替出力される。

【0027】以下、上記と同様の動作が繰り返される。と のようにして、上記の場合は、リニアアンプを用いたA PSによる動作が行われる。この動作状態において、例え は、太陽光や電球等明るい物体が撮影場面の中に入って きた場合、コラム選択スイッチ14から出力された映像 信号の、1フィールド(フレーム)内の最大照度と最低 照度に対応する各信号電圧レベルの差が大きくなる。電 圧比較回路15では、この差を求め、更にこの差が端子1 6を介して入力される参照電圧と比較して、これよりも 大きい時には、明るい場面であると判断して、ハイレベ ルの信号を切替回路17へ出力する。

【0028】切替回路17はこのハイレベルの信号入力 により、ハイレベルのスイッチングパルスaと、ローレ ベルのスイッチングパルスbを出力する。上記のハイレ ベルのスイッチングパルスaは、図2の端子21を介し てトランジスタM110、M120等のゲートに印加さ れて、これらのトランジスタM110、M120等をオ ンとする。また、これと同時に、上記のローレベルのスイ ッチングパルスbは、図2の端子22を介してトランジ スタM010、M020等のゲートに印加されて、これ らのトランジスタMO10、MO20等をオフとする。 【0029】トランジスタM110、M120がオンと なると、リセットパルスがゲートに印加されるべきトラ ンジスタM 1 1 1、M 2 1 1、M 1 2 0、M 2 2 1 等の ゲートには、リセットパルスに代えてトランジスタM1 10、M120のドレイン、ソースを介して電源電圧V ddがパイアス電圧として印加され、トランジスタM1 11、M211、M120、M221等はオン状態とな る以前のサブスレッショルド領域で動作する。このサブ スレッショルド領域では、ドレイン電流はゲート・ソー ス間の電圧に対して、指数関数的に増大する(対数曲線 を示す)。

【0030】従って、この状態でフォトダイオードD1 1、D21、D12、D22に光が照射されると、フォ トダイオードD11、D21、D12、D22で光電変 換された電流が流れ、この時のM111、M211、M 120、M221のソース電圧-D11、D21、D1 2、D22の光電流(ドレイン電流)の関係は、対数曲

線を示し、非常に広いダイナミックレンジが得られる。 【0031】その後、前述したように、図1の垂直シフ トレジスタ12からのハイレベルの垂直パルスに基づ き、ある1 H期間では、1 行目の水平方向に配列されて いるフォトダイオードD11、D21のカソード電圧変 化分が、トランジスタM113、M213等と負荷トラ ンジスタQ1、Q2等からなるソースフォロワ回路を通 して、図1のコラム選択スイッチ14へ映像信号として 出力され、次の1 H期間では、2 行目の水平方向に配列 されているフォトダイオードD12、D22のカソード 電圧変化分が、トランジスタM123、M223等と負 荷トランジスタQ1、Q2等からなるソースフォロワ回 路を通して、図1のコラム選択スイッチ14へ映像信号 として出力される。

【0032】コラム選択スイッチ14からは2行目の水 平ライン上の多数のフォトダイオードからの電圧変化分 が、1H内の映像期間内で順次切替出力される。以下、上 記と同様の動作が繰り返される。このようにして、高輝 度の物体があるダイナミックレンジの広い場面では、ロ グアンプを用いたAPS動作を画素部10に行わせると とができる。この動作状態において、トランジスタMO1 0及びM020はオフとされているため、リセットパル スcによる動作は行われず、リセット回路の停止による 省電力化を図ることができる。

【0033】上記のログアンプを用いたAPSによる動 作状態において、明るい物体が無い撮影場面に移った場 合は、コラム選択スイッチ14から出力された映像信号 の、1フィールド(フレーム)内の最大照度と最低照度 に対応する各信号電圧レベルの差が小さくなる。このと き、電圧比較回路15は、この差が端子16を介して入 力される参照電圧よりも小さくなり、暗い場面であると 判断して、ローレベルの信号を切替回路17へ出力す

【0034】との結果、切替回路17は、ローレベルの スイッチングパルスaと、ハイレベルのスイッチングパ ルスbを出力すると共に、リセットパルスcが順次に出 力し、画素部10を前述したリニアアンプを用いたAP Sの動作に切替制御する。

【0035】とのように、本実施の形態によれば、撮影画 面の明るさ(あるいはダイナミックレンジ)に応じて簡 単にログアンプからリニアアンプへ、あるいはその逆に 切り替えることができ、また、この切り替えに際して は、画素部10の各行毎に2個のトランジスタM010 (M020)及びM110 (M120)を設けるだけで よいため、画素部10の開口率の低下やデバイス面積の 増大によるコストの上昇が実質上ない。

【0036】なお、本発明は上記の実施の形態に限定さ れるものではなく、例えばリニアアンプとして使用する か、ログアンプとして使用するかの切り替えを手動で行 50 うようにしてもよい。

[0037]

 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 画素部をリニアアンプを用いた画素動作か、ログアンプを用いた画素動作を選択的に行えるため、高画質の撮影・がしたいときにはリニアアンプを用いた画素動作に、高輝度の物体があるときにはダイナミックレンジの広いログアンプを用いた画素動作というように、一つの装置で撮影対象に応じた最適な撮像動作を選択することができる。

【0038】また、本発明によれば、上記の選択動作は第1のトランジスタと第2のトランジスタを各行毎に追加するだけでよいので、画素部の開口率の低下や、固体撮像装置デバイス面積の増大によるコスト上昇を実質的にゼロに抑えることができる。

【0039】更に、本発明によれば、ログアンブを用いた画素動作をさせるときには、リセットバルスを不要にできるため、リセット回路の停止による省電力化を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態のブロック図である。 【図2】図1中の画素部と負荷トランジスタの各一部の 一実施の形態の回路図である。 * 【図3】従来の一画素回路の各例の等価回路図である。 【符号の説明】

- 10 画素部
- 11 負荷トランジスタ
- 12 垂直シフトレジスタ (VSR)
- 13 水平シフトレジスタ(HSR)
- 14 コラム選択スイッチ
- 1-5 電圧比較回路
- 16 参照電圧入力端子
- 10 17 切替回路
 - 21、22 スイッチング信号入力端子
 - 23、24 リセットパルス入力端子

M010、M020 リセット回路動作制御用スイッチングトランジスタ

M110、M120 リニアアンプ・ログアンプ切替用 トランジスタ

 $M\,1\,1\,1\,,\; M\,2\,1\,1\,,\; M\,1\,2\,1\,,\; M\,2\,2\,1\,,\; M\,1\,1\,2\,,$

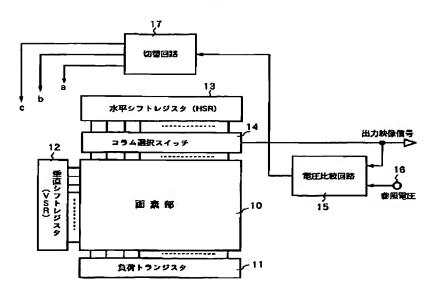
M212、M122、M222 トランジスタ

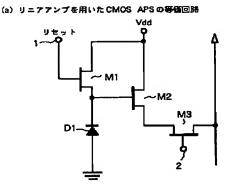
M113、M213、M123、M223 ロー選択ス イッチ用トランジスタ

D11、D21、D12、D22 フォトダイオード

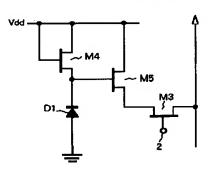
【図1】

【図3】

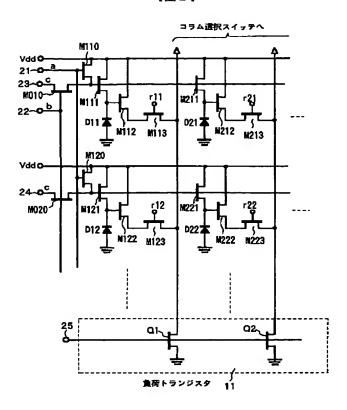




(b) ログアンプを用いたCMOS AP6の等価回路



[図2]



フロントページの続き

F ターム (参考) 4M118 AA02 AA04 AA10 AB01 BA14 CA02 DD09 DD12 FA06 5C024 CX00 CX43 CX03 GX16 GY31 HX17 HX20 HX29 HX40 HX50 5F049 MA01 NA20 NB05 UA01 UA05 UA13 UA14